

引用例 への写し

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 2 月 27 日 (27.02.2003)

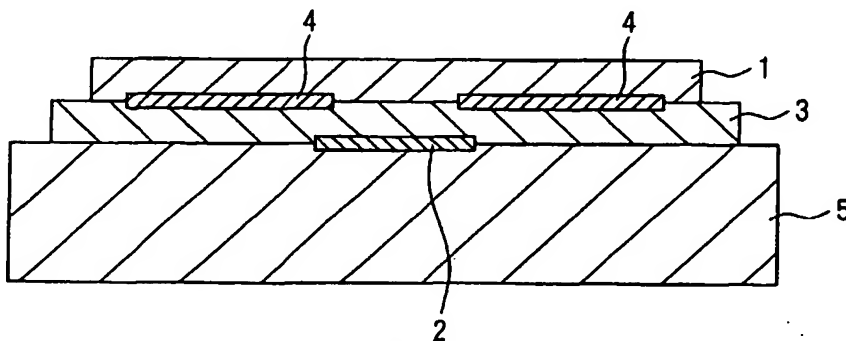
PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/016599 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C30B 29/54, 7/06, H01L 29/786, 51/00 (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (21) 国際出願番号: PCT/JP02/08070 (22) 国際出願日: 2002 年 8 月 7 日 (07.08.2002)
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2001-242808 2001 年 8 月 9 日 (09.08.2001) JP (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS; MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭化成株式会社 (ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒530-8205 大阪府 大阪市 北区堂島浜 1 丁目 2 番 6 号 Osaka (JP).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- (72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 南方 尚 (MINAKATA, Takashi) [JP/JP]; 〒421-3302 静岡県 庵原郡 富士川町中野台 1-15-5 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 森 哲也, 外 (MORI, Tetsuya et al.); 〒101-0032 東京都 千代田区 岩本町二丁目 3 番 3 号 友泉岩本町ビル 8 階 日栄国際特許事務所 Tokyo (JP).
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ORGANIC SEMICONDUCTOR ELEMENT

(54) 発明の名称: 有機半導体素子



(57) Abstract: An organic semiconductor thin film suitably employed in electronics, photonics, bioelectronics, or the like, and a method for forming the same. An organic semiconductor solution becoming the material of the organic semiconductor thin film, and an organic semiconductor element employing the organic semiconductor thin film are also provided. The transistor is obtained by forming a gate electrode (2), an insulator layer (3), a source

electrode, and drain electrodes (4, 4) sequentially on a glass substrate (5) and then applying o-dichlorobenzene solution of pentacene (0.05% by mass) and drying thereby forming an organic semiconductor thin film (1). Since the organic semiconductor thin film (1) can be formed easily at a low cost and has substantially no defect, a transistor having excellent electronic characteristics can be provided.

[続葉有]

WO 03/016599 A1